

C2727C

Le programme de R&D « Nano2017 » est officiellement lancé sur le site STMicroelectronics de Crolles

D'une durée de cinq ans, ce programme stratégique dirigé par ST a pour vocation d'accroître davantage encore le savoir-faire du Groupe dans les solutions et technologies de traitement embarquées

Crolles, France, le 22 juillet 2013 – STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce que le Premier Ministre, M. Jean-Marc Ayrault, accompagné d'Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, de Geneviève Fioraso, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Fleur Pellerin, Ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Économie numérique, de plusieurs représentants des autorités nationales, régionales et locales, et des dirigeants de ST se sont retrouvés ce jour sur le site ST de Crolles, près de Grenoble (Isère), pour inaugurer la lancement officiel du programme de recherche et développement Nano2017. Ont également assisté à cette cérémonie plusieurs partenaires clés de ST au sein du programme de R&D Nano2017, parmi lesquels le CEA-Leti et IBM.

Nano2017 est un programme public-privé stratégique de R&D d'une durée de cinq ans qui, sous la direction de ST, réunit de nombreux acteurs, dont le célèbre laboratoire de recherche français CEA-LETI — partenaire historique du centre de R&D de ST Crolles depuis sa création en 1992 —, plusieurs équipes de chercheurs universitaires, fabricants de matériaux et d'équipements, des fournisseurs et spécialistes de la propriété intellectuelle dans le domaine de la CAO, des intégrateurs de systèmes, ainsi que des PME et des intervenants européens. Le projet bénéficie du soutien des autorités françaises aux niveaux national, régional et local, ainsi que de la communauté européenne par le biais de l'initiative technologique commune (JTI) de l'ENIAC, le Conseil consultatif pour l'initiative européenne des nanotechnologies. Le financement du programme est sujet à l'approbation de la Commission européenne.

Le programme Nano2017 renforce le leadership de ST dans les technologies-clés : FD-SOI¹ (traitement de hautes performances et basse consommation), imagerie de nouvelle génération (capteurs et processeurs de signal d'images)² et mémoires non-volatiles embarquées de nouvelle génération³. Ces technologies sont au cœur des solutions de traitement embarquées de ST, telles que les microcontrôleurs, les solutions d'imagerie, les produits numériques grand public, les processeurs d'application et les ASIC numériques. Les technologies et les produits de traitement embarqués sont essentiellement développés dans les sites français de Crolles, Grenoble, Rousset et Sophia Antipolis. Le marché des solutions de traitement embarquées visé par ST est évalué à 67 milliards de dollars⁴ en 2013. ST dispose d'un potentiel de croissance significatif et de solides atouts pour augmenter ses parts de marché.

À propos de STMicroelectronics

ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme des technologies Sense & Power, les produits pour l'automobile et les solutions de traitement embarquées. De la gestion de la consommation aux économies d'énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « *life.augmented* ».

En 2012, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,49 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com

Contacts presse :

STMicroelectronics

Pascal Boulard

Tél : 01.58.07.75.96

Mobile : 06.14.16.80.17

pascal.boulard@st.com

¹ La technologie FD-SOI (Silicium sur isolant totalement déplétée – Fully Depleted-Silicon on Insulator) est une filière de nouvelle génération qui s'attaque à la plupart des défis liés à la réduction continue des traits des transistors à des géométries mesurant de l'ordre de dizaines ou centaines d'atomes. En raison des fuites du transistor, l'actuelle technologie de fabrication en silicium est de moins en moins efficace à partir des nœuds de 28 nm. La technologie FD-SOI apporte une alternative plus simple, plus rapide et qui dissipe moins de chaleur.

² Des développements sont attendus dans les domaines des capteurs d'images et du traitement des signaux d'image ; ils devraient permettre de créer des applications exceptionnelles douées du sens de la vision et qui pourraient optimiser le rendement énergétique, la sécurité, la facilité d'utilisation et la santé. Imaginez un téléviseur qui se mettrait en veille dès que son utilisateur le quitte des yeux, des véhicules et des résidences capables de reconnaître leur propriétaire, ou des équipements médicaux qui détecteraient des phénomènes de croissance inhabituels. De telles avancées seront rendues possibles par les progrès de l'imagerie.

³ Une mémoire non-volatile embarquée (eNVM) est un élément important de la quasi-totalité des systèmes sur puce. Les mémoires eNVM fonctionnent comme un programme ou un lieu de stockage de données intégré, où le système peut stocker en toute sécurité des *firmware*, codes de sécurité, données d'étalonnage et autres informations critiques pour les applications — et ce, même lorsque le système est hors tension.

⁴ Source : WSTS